

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-200833  
(P2019-200833A)

(43) 公開日 令和1年11月21日(2019.11.21)

(51) Int.Cl.

G 11 C 16/10 (2006.01)  
G 06 F 12/00 (2006.01)  
G 11 C 16/06 (2006.01)

F 1

G 11 C 16/10  
G 06 F 12/00  
G 11 C 16/06

テーマコード(参考)

5 B 1 6 0  
5 B 2 2 5

5 9 7 U

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

16/06

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

ホストに接続されたソリッドステート記憶デバイスのメモリアレイのフラッシュメモリインターフェイスを介してメモリアクセス動作を管理する方法であって、前記方法は、

前記メモリアレイ内で第1のメモリアクセス動作を実行することであって、前記第1のメモリアクセス動作は第1の優先度を有する、ことと、

前記メモリアレイ内で実行可能であり、前記第1の優先度よりも高い優先度を有する、少なくとも1つのメモリアクセス動作のサスPENDを検出することであって、前記検出動作は、メモリアクセス動作のサスPENDとメモリアクセス動作の非サスPENDとを区別する、ことと、

前記検出動作に応答して、前記メモリアレイ内の第1のメモリアクセス動作の実行をサスPENDすることと、

前記サスPEND動作に応答して、前記第1の優先度よりも高い優先度を有し、前記メモリアレイ内で実行可能である、1つ以上のメモリアクセス動作を、前記メモリアレイ内で実行可能である、前記第1の優先度よりも高い優先度を有するメモリアクセス動作が他になくなるまで実行することと、

前記実行動作の完了に応答して、前記メモリアレイ内の前記第1のメモリアクセス動作の実行を再開することと、を含む、方法。

**【請求項 2】**

前記再開動作の前に、前記第1の優先度よりも高い優先度を有し、少なくとも1つの時限サスPEND延長期間の満了前に前記メモリアレイ内で実行可能になる、前記メモリアレイ内の1つ以上の新たに利用可能なメモリアクセス動作を実行することであって、前記少なくとも1つの時限サスPEND延長期間は、前記1つ以上のメモリアクセス動作を実行する動作の終了後に開始する、ことを更に含む、請求項1に記載の方法。

**【請求項 3】**

前記メモリアレイ内で、1つ以上の新たに利用可能なメモリアクセス動作を実行する動作が、前記第1のメモリアクセス動作がサスPENDされたままである間、複数の時限サスPEND延長期間にわたって反復的に実行される、請求項1に記載の方法。

**【請求項 4】**

前記第1のメモリアクセス動作が、間隔のシーケンスに分割され、前記第1のメモリアクセス動作が、サスPEND前の前記間隔のうちの実行間隔で実行され、前記サスPEND動作が、

前記第1のメモリアクセス動作の前記実行間隔が完了するまで、前記第1のメモリアクセス動作のサスPENDを遅延させることと、

前記第1のメモリアクセス動作の前記実行間隔の完了後に、前記メモリアレイ内の前記第1のメモリアクセス動作の実行をサスPENDすることと、を含む、請求項1に記載の方法。

**【請求項 5】**

次の間隔が、前記間隔のシーケンス内の前記実行間隔に続き、前記再開動作は、

前記メモリアレイ内の前記第1のメモリアクセス動作の実行を、前記シーケンスの次の間隔で再開することを含む、請求項4に記載の方法。

**【請求項 6】**

前記実行動作が、

前記実行動作中に、前記メモリ内で実行可能なメモリアクセス動作の再開トリガの検出に応答して、前記メモリアレイ内の前記第1のメモリアクセス動作の実行を再開することを含む、請求項1に記載の方法。

**【請求項 7】**

前記第1のメモリアクセス動作がプログラム動作であり、前記プログラム動作よりも高い優先度を有する他のメモリアクセス動作のうちの少なくとも1つが、ホスト読み出し動作である、請求項1に記載の方法。

10

20

30

40

50

**【請求項 8】**

ネストされたレベルのサスPEND及び再開が、複数のレベルのより優先度の高いメモリアクセス動作に対して実行される、請求項1に記載の方法。

**【請求項 9】**

ホストに接続されたソリッドステート記憶デバイスにおいてメモリアクセス動作を管理するためのシステムであって、前記システムは、

1つ以上のメモリアレイと、

フラッシュメモリインターフェイスであって、前記1つ以上のメモリアレイに連結されたメモリコントローラを含み、

前記1つ以上のメモリアレイのうちのメモリアレイ内で第1のメモリアクセス動作を実行し（前記第1のメモリアクセス動作は第1の優先度を有する）、

前記メモリアレイ内で実行可能であり、前記第1の優先度よりも高い優先度を有する、少なくとも1つのメモリアクセス動作のサスPENDを検出し（前記検出動作はメモリアクセス動作のサスPENDとメモリアクセス動作の非サスPENDとを区別する）、

前記検出動作に応答して、前記メモリアレイ内の第1のメモリアクセス動作の実行をサスPENDし、

前記第1のメモリアクセス動作の実行のサスPENDに応答して、前記第1の優先度よりも高い優先度を有する、前記メモリアレイ内で実行可能な1つ以上のメモリアクセス動作を、前記メモリアレイ内で実行可能である、前記第1の優先度よりも高い優先度を有するメモリアクセス動作が他になくなるまで実行し、

前記実行動作の完了に応答して、前記メモリアレイ内の前記第1のメモリアクセス動作の実行を再開するように構成されている、フラッシュメモリインターフェイスと、を含む、システム。

**【請求項 10】**

前記メモリコントローラが、

前記1つ以上のメモリアクセス動作を実行する動作の終了後に、少なくとも1つの時限サスPEND延長期間を開始するタイマを含み、前記メモリコントローラは、前記再開動作の前に、前記第1の優先度よりも高い優先度を有し、前記少なくとも1つの時限サスPEND延長期間の満了前に前記メモリアレイ内で実行可能になる、前記メモリアレイ内の1つ以上の新たに利用可能なメモリアクセス動作を実行するように更に構成されている、請求項9に記載のシステム。

**【請求項 11】**

前記第1のメモリアクセス動作が、間隔のシーケンスに分割され、それぞれの間隔は、前記少なくとも1つの時限サスPEND延長期間よりも時間が長く、前記第1のメモリアクセス動作が、サスPENDの前に前記間隔のうちの実行間隔で実行され、前記メモリコントローラが、前記サスPEND動作を、

前記第1のメモリアクセス動作の前記実行間隔が完了するまで、前記第1のメモリアクセス動作のサスPENDを遅延させること、及び、

前記第1のメモリアクセス動作の前記実行間隔の完了後に、前記メモリアレイ内の前記第1のメモリアクセス動作の実行をサスPENDすること、により、前記サスPEND動作を実行するように更に構成されている、請求項10に記載のシステム。

**【請求項 12】**

次の間隔が、前記間隔のシーケンス内の前記実行間隔に続き、前記メモリコントローラが、前記シーケンスの次の間隔で前記メモリアレイ内の前記第1のメモリアクセス動作の実行を再開することによって、前記第1のメモリアクセス動作の実行を再開するように更に構成されている、請求項11に記載のシステム。

**【請求項 13】**

前記メモリコントローラが、前記メモリアレイ内の1つ以上の新たに利用可能なメモリアクセス動作を、前記第1のメモリアクセス動作がサスPENDされたままである間、複数の時限サスPEND延長期間にわたって反復的に実行するように更に構成されている、請求

10

20

30

40

50

項 9 に記載のシステム。

【請求項 14】

前記第 1 のメモリアクセス動作がプログラム動作であり、前記プログラム動作よりも高い優先度を有する他のメモリアクセス動作のうちの少なくとも 1 つが、ホスト読み出し動作である、請求項 9 に記載のシステム。

【請求項 15】

前記メモリコントローラが、前記 1 つ以上のメモリアクセス動作の実行を中断し、再開トリガ条件が満たされたときに前記第 1 のメモリアクセス動作を再開するように更に構成されており、前記第 1 の優先度よりも高い優先度を有する少なくとも 1 つのメモリアクセス動作が、前記メモリアレイ内で実行可能なままである、請求項 9 に記載のシステム。

10

【請求項 16】

より高い優先度を有するメモリアクセス動作が、より低い優先度を有するメモリアクセス動作より先に利用可能にされる、請求項 9 に記載のシステム。

【請求項 17】

ホストに接続されたソリッドステート記憶デバイスのメモリアレイのフラッシュメモリインターフェイスを介してメモリアクセス動作を管理するプロセスをプロセッサ上で実行するためのプロセッサ実行可能命令を符号化する 1 つ以上の有形プロセッサ可読記憶媒体であって、前記プロセスは、

前記メモリアレイ内で第 1 のメモリアクセス動作を実行することであって、前記第 1 のメモリアクセス動作は第 1 の優先度を有する、ことと、

20

前記メモリアレイ内で実行可能であり、前記第 1 の優先度よりも高い優先度を有する、少なくとも 1 つのメモリアクセス動作のサスPENDを検出することであって、前記検出動作は、メモリアクセス動作のサスPENDとメモリアクセス動作の非サスPENDとを区別する、ことと、

前記検出動作に応答して、前記メモリアレイ内の第 1 のメモリアクセス動作の実行をサスPENDすることと、

前記サスPEND動作に応答して、前記第 1 の優先度よりも高い優先度を有し、実行可能である、前記メモリアレイ内の 1 つ以上のメモリアクセス動作を、前記メモリアレイ内で実行可能である、前記第 1 の優先度よりも高い優先度を有するメモリアクセス動作が他になくなるまで実行することと、

30

前記実行動作の完了に応答して、前記メモリアレイ内の前記第 1 のメモリアクセス動作の実行を再開することと、を含む、1 つ以上の有形プロセッサ可読記憶媒体。

【請求項 18】

前記再開動作の前に、前記第 1 の優先度よりも高い優先度を有し、少なくとも 1 つの時限サスPEND延長期間の満了前に前記メモリアレイ内で実行可能になる、前記メモリアレイ内の 1 つ以上の新たに利用可能なメモリアクセス動作を実行することを更に含み、前記少なくとも 1 つの時限サスPEND延長期間は、前記 1 つ以上のメモリアクセス動作を実行する動作の終了後に開始する、請求項 17 に記載の 1 つ以上の有形プロセッサ可読記憶媒体。

40

【請求項 19】

前記第 1 のメモリアクセス動作がプログラム動作であり、前記プログラム動作よりも高い優先度を有する他のメモリアクセス動作のうちの少なくとも 1 つが、ホスト読み出し動作である、請求項 17 に記載の 1 つ以上の有形プロセッサ可読記憶媒体。

【請求項 20】

前記第 1 のメモリアクセス動作がプログラム動作であり、前記プログラム動作よりも高い優先度を有する他のメモリアクセス動作のうちの少なくとも 1 つが、マップ読み出し動作である、請求項 17 に記載の 1 つ以上の有形プロセッサ可読記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【背景技術】

【0001】

50

3D フラッシュメモリは、2D フラッシュメモリ技術よりも長いプログラム時間を伴う。複数のメモリページが単一の動作でプログラムされるワンショットプログラミングの実行によって、より長いプログラム時間が増加する可能性があり、それにより、ビジーなダイ上に有意なボトルネックが生じ得る。読み出し / 書き込みが混在するワークロードでは、より長いプログラム時間により、他のより優先度の高い動作に対するボトルネックが生じ得る。例えば、読み出し動作は、ダイ上の長いプログラム動作によってロックされたときに、長い待ち時間を経験し得る。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【0002】

本明細書に開示される実施例は、ホストに接続されたソリッドステート記憶デバイスのメモリアレイのフラッシュメモリインターフェイスを介してメモリアクセス動作を管理するためのシステム及び方法を提供する。メモリコントローラは、メモリアレイ内で第1のメモリアクセス動作を実行する。第1のメモリアクセス動作は、第1の優先度を有する。メモリコントローラは、メモリアレイ内で実行可能であり、第1の優先度よりも高い優先度を有する、少なくとも1つのメモリアクセス動作のサスPENDを検出する。検出動作は、メモリアクセス動作のサスPENDとメモリアクセス動作の非サスPENDとを区別する。メモリコントローラは、メモリアレイ内の第1のメモリアクセス動作の実行をサスPENDし、第1の優先度よりも高い優先度を有する、メモリアレイ内で実行可能な1つ以上のメモリアクセス動作を、メモリアレイ内で実行可能である、第1の優先度よりも高い優先度を有するメモリアクセス動作が他になくなるまで実行する。メモリコントローラは、実行動作の完了に応答して、メモリアレイ内の第1のメモリアクセス動作の実行を再開する。

【0003】

この「発明の概要」は、「発明を実施するための形態」において以下に更に説明される簡潔な形態で概念の選択を紹介するために提供される。この「発明の概要」は、「特許請求の範囲」に記載された対象の重要な特徴又は本質的特徴を識別するようには意図されず、かつ「特許請求の範囲」に記載された対象の範囲を限定するために使用されるようには意図されない。これら及び様々な他の特徴及び利点は、以下の「発明を実施するための形態」を読むことで明らかとなるであろう。

【0004】

他の実施例もまた、本明細書に説明及び列記される。

【図面の簡単な説明】

【0005】

【図1】スケジュールされたメモリアレイ動作のサスPEND / 再開制御をメモリアレイに提供するための例示的なメモリコントローラを示す。

【図2】少なくとも3次元にデータを格納するのに好適なメモリアレイを含むメモリデバイスの一例を示す。

【図3】メモリアクセス動作のサスPEND及び再開をスケジュール及び実施するための例示的な動作を示す。

【図4】メモリアクセス動作のサスPEND及び再開を管理するための例示的な動作を示す。

【図5】本明細書に記載された技術を実施するのに有用であり得る例示的な処理システムを示す。

【発明を実施するための形態】

【0006】

図1は、スケジュールされたメモリアレイ動作のサスPEND / 再開制御をメモリアレイ100(データアレイとも称される)に提供するための例示的なメモリコントローラ126を示す。メモリアレイ100は、異なるインクリメンタルステップパルスプログラム(ISP)電圧を介してプログラム可能なメモリセル(例えば、メモリセル102)を含む。メモリアレイのメモリセルは、一般にNANDストリングと呼ばれるもので直列に接

10

20

30

40

50

続されている複数の浮遊ゲートトランジスタメモリセルを含む。このタイプのメモリアレイ 100 は、NAND フラッシュメモリとして知られている。NAND フラッシュは、開示された技術での使用に好適なメモリタイプの単に一例であることを理解されたい。

#### 【0007】

それぞれのNANDストリングは、ビット線（例えば、記号が出力バス（例えば、バス 108）を介して読み取られ得るビット線 106）に連結される。隣接するNANDストリングのセルは、メモリセルのどの列が読み出し動作及びプログラム動作の影響を受けるかを選択するワード線（例えば、ワード線 110）を介して連結される。選択ゲート 112、114 はまた、読み出し動作及びプログラム動作中に、NANDストリングをそれぞれのビット線及び接地に選択的に連結する。一般に、それぞれのワード線は、物理的にアドレス可能な最小のデータユニットである 1 つ以上のページ（例えば、ページ 118）に関連付けられ得る。ビット単位のページのサイズ（ユーザーデータ及びエラー訂正コード、すなわち ECC の両方を含み得る）は、ワード線内のNANDストリングの数に対応する。MLC メモリアレイは、対応するビット（例えば、それぞれのページからの全てのビット 0）をそれぞれのセル内の固有の電荷レベルに符号化することによって、ワード線上に複数のページを格納する。

10

#### 【0008】

フラッシュメモリは、浮遊ゲートを特定の電圧に充電することによって状態を保持する。これにより、指定された読み出し電圧が印加されると、既定量の電流がチャネルを流れる。メモリセル 102 の拡大図 101 は、フラッシュメモリセルトランジスタを示す。フラッシュメモリセルトランジスタは、基板 136 の表面に位置するソース領域 134 及びドレイン領域 132 を含む。ゲート構造は、ソース領域 134 とドレイン領域 132 との間に画定されたチャネル領域上で位置合わせされる。ゲート構造は、浮遊ゲート 130 及び制御ゲート 140 を含む。図示されていないが、浮遊ゲート 130 と基板の表面との間にトンネリング誘電体層が介在し、浮遊ゲート 130 と制御ゲート 140 との間に別の薄い酸化物層又は制御誘電体が介在している。示されている例では、ドレイン電圧  $V_d$  はビット線 BL から供給され、制御ゲート電圧  $V_{cg}$  はワード線 WL から供給され、ソース電圧  $V_s$  は接地などの基準電位に接続されている。

20

#### 【0009】

初期状態からプログラムされた状態にメモリセルトランジスタを変更（プログラム）するため、ファウラーノルドハイム（FN）トンネリングとして知られるプロセスが利用される。簡潔に言えば、制御ゲート 140 と基板 136 との間に比較的大きな正電位差が生じ、基板 136 の表面上のチャネル内の励起電子は、浮遊ゲート 130 に押し進められ、そこにトラップされる。これらの負電荷を持つ電子は、制御ゲート 140 と基板 136 上のチャネルとの間の障壁として機能し、メモリセルトランジスタの閾値電圧を増加させる。メモリセルトランジスタは、制御ゲート 140 と基板との間に大きな負の電位差を形成することによって、その初期状態に戻すことができ、これは、浮遊ゲート 130 と基板 136 との間に薄い酸化物層にわたって電子を引き戻し、それにより電子障壁を除去し、メモリセル 102 の閾値電圧を低下させる。

30

#### 【0010】

シングルレベルセル（SLC）記憶デバイスでは、それぞれのメモリセルトランジスタが、2つの可能なメモリ状態（「0」又は「1」）のうちの1つに対応する電圧を格納する。例えば、メモリ状態「0」は、第1の電圧範囲に対応し得、メモリ状態「1」は、第2の電圧範囲に対応し得る。

40

#### 【0011】

マルチレベルセル（MLC）記憶デバイスでは、それぞれのメモリセルトランジスタは、2つ以上のデータビットを格納し、メモリセルトランジスタは、1及び0の可能な組み合わせのうちの異なる1つをそれぞれ表す、一定範囲の可能な電圧のうちのいずれかを想定し得る。例えば、それぞれのメモリセルトランジスタが2つのデータビットを格納する場合、メモリセルトランジスタは、状態 00、01、10 及び 11 にそれぞれ対応する

50

つの異なる電圧範囲のうちの1つの範囲に入る電圧を有し得る。加えて、トリプルレベルセル（TLC）記憶デバイス内のメモリセルトランジスタは、セルごとに3つのビットを格納し、クアッドレベルセル（QLC）記憶デバイス内のメモリセルトランジスタは、セルごとに4つのビットを格納する。

【0012】

インクリメンタルステップパルスプログラミング（ISPP）は、MLC及びSLCトランジスタにおけるメモリ状態をプログラムするための1つの手法である。プログラムメモリアクセス動作は、メモリへの書き込みとして機能する。ISPPでは、プログラム電圧は、大きさが増加する短い連続したプログラムパルスを使用して、選択されたメモリセルの制御ゲートに印加される。例えば、ページがプログラミング動作のために選択される場合、バイアス電圧は、ページのメモリセルが接続されるワード線に印加される。ISPPプログラミング方法は、ステップ電圧基準でワード線バイアス電圧を徐々に増加させながら、選択されたページを数回プログラムする。

10

【0013】

増加した「ステップ」電圧のそれぞれのパルス間で、プログラム検証動作が実行され、選択されたメモリセルの閾値電圧がプログラム検証電圧レベルを超えて上昇しているか否かをチェックする。ISPPプロセスは、選択されたメモリセル（例えば、ページ104のセル）のそれぞれの閾値電圧がプログラム検証レベルを超えて上昇するまで継続する。

20

【0014】

選択されたメモリセルの閾値電圧がプログラム検証電圧レベルを超えることを必要とすることにより、ISPPプロセスは、選択されたメモリセルの可能なプログラム状態ごとに閾値電圧分布に関する下限を効果的に制御する。プログラム電圧を短いパルスで制御ゲートに印加することにより、ISPPプロセスは、選択されたメモリセルの閾値電圧がプログラム検証電圧レベルを超えて有意に増加することを防止し、それにより、メモリセルのプログラムされた状態ごとに閾値電圧分布での妥当な上限を維持する。

20

【0015】

プログラム動作は、特に読み出し動作と比較して非常に長くなり得る。したがって、記載された技術におけるメモリコントローラ126は、様々な種類の読み出し動作（又は他のより優先度の高いメモリアクセス動作）の利益となるように、プログラム動作（又は他のより優先度の低いメモリアクセス動作）のサスPEND及び再開をスケジュールする。このように、より優先度の高い動作は、長く、より優先度の低い動作によってブロックされる可能性が低い。

30

【0016】

3D NANDでは、ワード線内の全てのページが本質的に一緒にプログラムされている、ワンショットプログラミングアルゴリズムが採用されることが多い。したがって、3D NANDのプログラム時間は、読み出し時間と比較して長くなり得、特に平面又は2D NANDよりも長くなり得る。平面NANDでは、マルチステッププログラミングアルゴリズムが典型的に採用され、ページは互いに独立してプログラムされる。3D NANDでは、ワード線ごとにより多くのページが存在するため、プログラム時間は、セルごとに記憶されたビット数と共に増加する。したがって、TLC及びQLC NANDのプログラム時間は、典型的には、MLC 2ビット/セルNANDよりも大きい。サービス特性の良好な性能及び品質を得るために、プログラムのサスPEND動作は、以下に記載されるように、先行的な読み出し動作を可能にする。

40

【0017】

図2は、ホスト230及びソリッドステート記憶デバイス202を含む例示的なシステム200を示す。ソリッドステート記憶デバイス202は、少なくとも3次元でデータを格納するのに好適な1つ以上のメモリアレイ（例えば、データアレイとも称されるメモリアレイ204）を含む。このタイプのメモリブロックは、ワード線（例えば、ワード線210）を介して連結された隣接するNANDストリングのセルを含む3D NANDブロックを含み、また、NANDストリングをそれぞれのビット線（例えば、ビット線211

50

)に選択的に連結する選択ゲートを含む。チャネルストリング(212)と称される3次元のメモリセルは、対応するビット線及び対応するチャネル選択線を活性化することによって選択される。3D NANDフラッシュでは、ワード線方向の集合は、ワード線面と称されることもある。以下に記載されるスクランブル方法は、ビット線(BL)、ワード線(WL)及びチャネル選択線(CSL)方向のそれぞれにおいて3次元データランダム化をもたらす。

#### 【0018】

ホスト230は、読み出し動作、書き込み動作及び消去動作などのメモリアクセス動作の命令をメモリコントローラ206に発行して、メモリアレイ204に対するデータの読み取り/書き込みを行い得る。加えて、メモリコントローラ206はまた、ホスト230からの明示的な命令なしに、メモリアクセス動作を実行し得る。例えば、メモリコントローラ206は、再試行読み出し動作、再利用読み出し動作、再マッピング読み出し動作、及び再マッピングプログラム動作を発行してもよい。

10

#### 【0019】

それぞれのタイプの動作、及びいくつかの実施態様では個々のメモリアクセス動作自体は、ホストによるか又はメモリコントローラ構成によるかにかかわらず、優先度レベルで指定されてもよい。例えば、メモリコントローラ構成は、特定のプログラム動作よりも高い優先度を有する特定の読み出し動作を指定してもよい。このようにして、メモリコントローラ206は、1つ以上の読み出し動作の利益となるように、より優先度の低いプログラム動作のサスPEND及び再開をスケジュールし得る。少なくとも1つの実施例では、任意のメモリアクセス間隔で到達する、高優先度として(例えばファームウェアによって)マーク付けされたメモリアレイに対する任意のホスト読み出しコマンドは、そのメモリアレイがより優先度の低い別のメモリアクセス動作によりビジーである場合には、現在のメモリアクセス間隔が完了した後に、そのメモリアレイに対するサスPENDコマンドをトリガすることになる。

20

#### 【0020】

一実施例では、メモリコントローラ206は、フロントエンドインターフェイス回路220、仮想化回路222、及びメディアエンジン回路224を含む回路(例えば、ASI Cとして)で実施される。フロントエンドインターフェイス回路220は、ホストメモリアクセス動作命令及びデータをホスト230と通信する。仮想化回路222は、ソリッドステート記憶デバイスの多数のメモリアレイ内の仮想メモリアドレスと物理メモリアドレスとを変換する。メディアエンジン回路224は、フラッシュメディアエンジン(FME)回路と、チャネルごとの個々のフラッシュ変換インターフェイス(FTI)回路とを含み、これらの回路は、ソリッドステート記憶デバイス内の個々のメモリアレイへの様々なメモリアクセス動作の制御及びデータ通信を提供する。例示的なメモリアクセス動作としては、限定されるものではないが、読み出し、プログラム、及び消去動作が挙げられ得る。

30

#### 【0021】

様々な実施例では、メディアエンジン回路224は、本明細書に記載されたプロセスに従ってサスPEND及び再開アクションをスケジュールする。メディアエンジン回路224は、デバイス構成メモリ226(例えば、このようなメモリ226に格納されたデバイス構成ファイル)に格納されたデバイス構成パラメータにアクセスして、プロセスで使用されるタイミング及びカウントを調整する。いくつかの実施態様では、サスPEND/再開機能を制御するファームウェアは、そのようなデバイス構成パラメータにアクセスして、ファームウェアを再構築及び再インストールすることなく、サスPEND/再開機能の動作の変更を可能にし得る。例示的なパラメータとしては、限定されるものではないが、予め指定された時間の間に又は予め指定された数のメモリアクセス動作の間に許容される最大サスPEND数、時限サスPEND延長期間のサイズ、メモリアクセス動作間隔のサイズ、及び異なるメモリアクセス動作又はメモリアクセス動作のタイプの相対的な優先度が挙げられ得る。

40

50

**【0022】**

いくつかの実施態様では、サスPEND及び再開がネストされてもよいことを理解されたい。例えば、第1のメモリアクセス動作は、第2の(より優先度の高い)メモリアクセス動作の実行を可能にするためにサスPENDされる。その後、第1のメモリアクセス動作がサスPENDされている間に、第2の(より優先度の高い)メモリアクセス動作が、第3の(更に優先度の高い)メモリアクセス動作の実行を可能にするためにサスPENDされる。ネストされたサスPENDレベルの数は、任意の特定の数に限定される必要はなく、それぞれのレベルのサスPENDは、サスPENDされた動作を再開する前に、より優先度の高い複数のメモリアクセス動作が完了することを可能にし得る。サスPENDされた動作を再開することは、サスPENDすることと比較して逆の順序で実行される。サスPEND／再開レベルの数、サスPEND時間の量、サスPENDの数などに対する他の制限も採用されてよい。一例では、第1のメモリアクセス動作は消去動作であり、第2のメモリアクセス動作はプログラム動作(消去動作の優先度よりも高い優先度を有する)であり、第3のメモリアクセス動作は読み出し動作(消去動作及び読み出し動作の優先度よりも高い優先度を有する)である。

10

**【0023】**

図3は、メモリアクセス動作のサスPEND及び再開をスケジュール及び実施するための例示的な動作300を示す。開始動作302は、現在のメモリアレイ内のLUN(i)(論理ユニット番号)へのメモリアクセス動作を開始する。メモリアクセス動作は、優先度に起因し、それぞれの間隔の完了時にメモリアクセス動作の安全なサスPENDを可能にするように設定された間隔のシーケンスに分割される。いくつかの実施例では、間隔は同サイズであるが、他の実施例は、異なるサイズの間隔を採用してもよい。また、いくつかの実施例では、間隔は、間隔の開始及び終了を設定するタイマに基づいて時限設定される。遅延動作304は、開始動作302の後、現在実行中のメモリアクセス動作間隔が完了するまで待機する。遅延動作304は、メモリアクセス動作がその実行中の安全でない点でサスPENDされないことを確実にする。同サイズの間隔はまた、サービス性能の品質に有益である読み出し時間待ち時間の予測可能性を提供する。

20

**【0024】**

決定動作306は、少なくとも1つのより優先度の高いメモリアクセス動作が、現在のメモリアレイ内で実行可能であるか否かを判定する。一実施例では、決定動作306は、現在のメモリアレイに対する様々な読み出し、プログラム、及び消去要求が追加される待ち行列を評価してもよい。一例では、開始動作302は、第1の優先度を有するプログラム動作を実行してもよく、決定動作306は、1つ以上の読み出し動作が待ち行列に受信されており、第1の優先度よりも高い優先度を有することを判定し得る。現在のメモリアレイ内で実行可能な、より優先度の高いメモリアクセス動作が存在しない場合、処理は、遅延動作304に再びループバックして、メモリアクセス動作の実行を継続する。より優先度の低いメモリアクセス動作を待ち行列内でより後方に維持しながら、より優先度の高いメモリアクセス動作を待ち行列の前方にプッシュするように、様々なメモリアクセス動作を1つ以上の待ち行列内で再順序付けし得ることを理解されたい。このようにして、より優先度のメモリアクセス動作は、より低い優先度を有するメモリアクセス動作を先に利用可能にし得る。

30

**【0025】**

1つ以上のより優先度の高いメモリアクセス動作が、現在のメモリアレイ内で実行可能である場合、別の決定動作308は、同じメモリアクセス動作に対するサスPENDが多すぎる、同じメモリアレイ内である期間のサスPENDが多すぎる、など、このメモリアレイ内で発行されたサスPENDが多すぎるか否かを判定する。そうである場合、処理は、遅延動作304に再びループバックして、メモリアクセス動作の実行を継続する。そうでなければ、サスPEND動作310が、LUN(i)への現在実行中のメモリアクセス動作をサスPENDし、実行動作312が、より優先度の高い1つ以上の利用可能なメモリアクセス動作を実行する。決定動作314は、1つ以上のより優先度の高いメモリアクセス動作が

40

50

、メモリアレイ内で実行可能であるか否かを判定する。そうである場合には、処理は、実行動作 312 にループバックする。

【0026】

メモリアレイ内で実行可能である、より優先度の高いメモリアクセス動作がなくなると、別の遅延動作 316 が、時限サスペンド延長期間の満了を待機する。別の決定動作 318 は、1つ以上のより優先度の高いメモリアクセス動作がメモリアレイ内で実行可能であるか否かを判定する。そのような動作は、時限サスペンド延長期間中に使用可能になるため、「新たに利用可能」と見なされる。1つ以上の新たに利用可能なメモリアクセス動作が、現在のメモリアレイ内で実行可能である場合、実行動作 320 は、それらの新たに利用可能なメモリアクセス動作を実行し、処理は遅延動作 316 に戻る。そうでなければ、再開動作 322 は、より優先度の低いメモリ動作の間隔のシーケンスにおける次の間隔で、より優先度の低いメモリ動作の実行を再開する。

10

【0027】

動作優先度の適用は、設計目的に基づいて変更することができる。例えば、いくつかの実施例では、任意の読み出し動作は、プログラム動作又は消去動作よりも高い優先度を有することになる。他の実施例では、読み出しの再試行動作は、サスペンドされたメモリアクセス動作の再開をブロックしないが、それ以外の場合、それらは任意の他の読み出し動作のように処理される。多くの他の変更例が想到される。メモリアクセス動作の相対的な優先度は、ホスト及び記憶デバイスからの装置構成パラメータ及び命令に応じて変更してもよい。

20

【0028】

以下に、異なる優先度を有するメモリアクセス動作がどのように処理され得るかについてのいくつかの具体的な例を提供するが、他の変更例を採用してもよい。

【0029】

待ち行列内に存在する場合にプログラム動作をサスペンドする、メモリアクセス動作のサスペンド

ホスト読み出し動作

マップ読み出し動作（マップエントリがキャッシュされていない場合）。「マップ」は、論理アドレスと物理アドレスとの間のマッピングを格納するメタデータを指す。

30

【0030】

電力イベント又は停電からのドライブの回復を可能にする、チェックポイント読み出し動作（例えば、メタデータの読み出し動作）

サスペンド中に待ち行列に到着したか又は待ち行列内にある場合、サスペンド中に実行する（ただし、サスペンドをトリガしない）メモリアクセス動作の非サスペンド

再利用読み出し動作

全てのエラー回復及びフラッシュポリシー読み出し動作（バックグラウンドスクラップ及びコードレート試験動作中の読み出し動作など）

40

第1の読み出し効果に対処するためなど、読み出し基準電圧、エラー訂正コード、及びコードレート設定といった SSD のパラメータを較正及び調整するためのバックグラウンド読み出し動作

サスペンドをトリガすることもサスペンド中に実行することもできず、プログラム動作がサスペンドされている場合に再開させる、読み出し動作の再開トリガ（低優先度）

ルートファイルシステム読み出し動作

図 4 は、メモリアクセス動作のサスペンド及び再開を管理するための例示的な動作 400 を示す。実行動作 402 は、メモリアレイ内で第1のメモリアクセス動作を実行する。第1のメモリアクセス動作は、第1の優先度を有する。検出動作 404 は、メモリアレイ内で実行可能であり、第1の優先度よりも高い優先度を有する、少なくとも1つのメモリアクセス動作のサスペンドを検出する。検出動作 404 はまた、メモリアクセス動作のサスペンドとメモリアクセス動作の非サスペンド（及びいくつかの実施例ではメモリアクセス動作の再開トリガ）とを区別する。サスペンド動作 406 は、少なくとも1つのより優

50

先度の高いメモリアクセス動作のサスPENDがメモリアレイ内で実行可能であると判定された場合、現在実行中のメモリアクセス動作の実行をサスPENDする。1つ以上のメモリアクセス動作の非サスPENDが、利用可能であり、第1の優先度よりも高い優先度を有するものとして検出されているが、利用可能であり、第1の優先度よりも高い優先度を有するものとして検出されたメモリアクセス動作のサスPENDがない場合、サスPEND動作406は実行しない。一実施例では、サスPEND動作406は、サスPENDを開始する前に、メモリアクセス動作の現在実行中の間隔が完了するまで待機する。

#### 【0031】

実行動作408は、サスPEND動作406が完了した後に利用可能になる新しくより優先度の高いメモリアクセス動作を含む、利用可能なより優先度の高いメモリアクセス動作を実行する。実行動作408は、メモリアレイ内で実行可能である、より優先度の高い追加のメモリアクセス動作がないと完了する。別の実行動作410は、時限サスPEND延長期間の満了後、時限サスPEND延長期間中に利用可能になった、新たに利用可能な任意のより優先度の高いメモリアクセス動作を実行する。実行動作410はまた、時限サスPEND延長期間の終了時に利用可能である、より優先度の高いメモリアクセス動作がなくなるまで、複数の時限サスPEND延長期間を通して繰り返され得る。再開動作412は、より優先度の低いメモリアクセス動作の実行を再開する。いくつかの実施例では、実行動作410は省略されてもよい。

10

#### 【0032】

いくつかの実施例では、実行動作408又は実行動作410のいずれかの完了前に、サスPENDされたメモリアクセス動作を再開するための1つ以上の再開トリガ条件が設定されてもよい。例えば、再開トリガ条件は、タイマの満了に設定されてもよく、それにより、メモリコントローラがメモリアレイ内で実行可能である、より優先度の高い追加のメモリアクセス動作がないことを検出したときではなく、メモリコントローラがタイマの満了を検出したときに、実行動作408は完了する。別の例では、再開トリガ条件は、より優先度の高いメモリアクセス動作の最大カウントに設定されてもよく、それにより、メモリコントローラが、メモリアレイ内で実行可能である、より優先度の高い追加のメモリアクセス動作がないことを検出したときではなく、メモリコントローラが、サスPEND中に実行するより優先度の高いメモリアクセス動作の数がより優先度の高いメモリアクセス動作の最大カウントに一致するか又はそれを超えたことを検出したときに、実行動作408は完了する。更に別の例では、再開トリガ条件は、(例えば、ある期間にわたる)実行されたより優先度の高いメモリアクセス動作と(例えば、その期間にわたる)より優先度の低いメモリアクセス動作との所望の比率に設定されてもよく、それにより、メモリコントローラが、メモリアレイ内で実行可能である、より優先度の高い追加のメモリアクセス動作がないことを検出したときではなく、メモリコントローラが、実行されたより優先度の高いメモリアクセス動作と実行されたより優先度の低いメモリアクセス動作との比率が、既定の最大閾値に一致するか又はそれを超えたことを検出したときに、実行動作408は完了する。

20

30

#### 【0033】

実 행동作408が完了する前に、メモリアクセス動作の再開トリガがメモリアレイ内で実行可能として検出された場合、その優先度が、サスPEND中に実行するより優先度の高いメモリアクセス動作よりも低い場合でも、実行中のメモリアクセス動作は終了し、第1のメモリアクセス動作の実行が再開動作412において再開される。

40

#### 【0034】

そのような再開トリガ条件はまた、実行動作410を先行させるか又は早期に終了させ、再開動作412をトリガするために適用されてもよい。他の先行的な再開条件が想到される。

#### 【0035】

図5は、記載された技術を実施するのに有用であり得る例示的な処理システム500を示す。処理システム500は、コンピュータプロセスを実行するための有形コンピュータ

50

可読（又はプロセッサ可読）記憶媒体内に具現化されたコンピュータプログラム製品を実行することができる。データ及びプログラムファイルは、処理システム500に入力されてもよく、処理システム500は、1つ以上のプロセッサ（例えば、CPU、GPU、ASIC）を使用してファイルを読み出し、その中のプログラムを実行する。処理システム500の要素のうちのいくつかが図5に示されており、図中、入力／出力（I/O）セクション504、1つ以上のプロセッサ506、及びメモリ508を有するプロセッサ502が示されている。1つ以上のプロセッサ506は、1つ以上の処理デバイス又はコアを含んでもよい。プロセッサは、シングルコア又はマルチコアプロセッサであってもよい。処理システム500は、従来のコンピュータ、分散コンピュータ、コントローラボード、ASIC、又は任意の他のタイプの処理システムであってもよい。記載された技術は、メモリ508にロードされたソフトウェア、記憶ユニット512に任意選択的に実施され、かつ／又はキャリア信号（例えば、イーサネット（登録商標）、3G無線、5G無線、LTE（ロングタームエボリューション）など）上で有線又は無線ネットワークリンク514を介して通信され、それによって、図5中の処理システム500は、記載された動作を実施するための特定用途向けマシンに変換される。処理システム500は、本明細書に開示されているディスクドライブスループットバランス調整システムを支持するように構成されている、特定用途向け処理システムであってもよい。

10

## 【0036】

I/Oセクション504は、1つ以上のユーザーインターフェイスデバイス（例えば、キーボード、タッチスクリーン表示ユニット518など）又は記憶ユニット512に接続されてもよい。記載された技術に従ってシステム及び方法を達成する機構を含むコンピュータプログラム製品は、メモリ508内又はそのようなシステム500の記憶ユニット512上に存在してもよい。

20

## 【0037】

通信インターフェイス524は、ネットワークリンク514を介して処理システム500を企業ネットワークに接続することができ、コンピュータシステムは、ネットワークリンク514を通じて、搬送波内に具現化された命令及びデータを受信し得る。ローカルエリアネットワーク（LAN）環境で使用される場合、処理システム500は、通信デバイスの1つのタイプである通信インターフェイス524を介してローカルネットワークに（有線接続又は無線で）接続される。広域ネットワーク（WAN）環境で使用される場合、処理システム500としては、典型的には、モデム、ネットワークアダプタ、又は広域ネットワークを介した通信を確立するための任意の他のタイプの通信デバイスが挙げられる。ネットワーク化された環境では、処理システム500又はその一部に対して示されるプログラムモジュールは、リモートメモリ記憶デバイス内に記憶されてもよい。図示されているネットワーク接続は、コンピュータ間の通信リンクを確立するための通信デバイスの例であり、他の手段を使用してもよいことが理解される。

30

## 【0038】

例示的実施例では、メモリコントローラ及び他のモジュールを制御するファームウェアは、メモリ508及び／又は記憶ユニット512に記憶され、プロセッサ502によって実行されるプロセッサ実行可能命令によって具現化されてもよい。更に、記憶コントローラは、RAID0の実施例を支持するように構成されてもよい。RAID記憶域は、汎用コンピュータ及び専用ソフトウェア（サービスソフトウェアを実行するサーバなど）、特定用途向けコンピューティングシステム及び専用ソフトウェア（サービスソフトウェアを実行するモバイルデバイス又はネットワーク機器など）、又は他のコンピューティング構成を使用して実施されてもよい。加えて、間隔サイズ、優先度、読み出し／プログラムデータ、並びに他のデータ及びパラメータは、メモリ508及び／又は記憶ユニット512に格納され、プロセッサ502によって実行されてもよい。

40

## 【0039】

処理システム500は、ユーザーデバイス、記憶デバイス、I/Oデバイス、デスクトップ、ラップトップ、コンピューティングデバイスなどのデバイス内に実装されてもよい

50

。処理システム 500 は、ユーザーデバイス内又はユーザーデバイスの外部で実行する記憶デバイスであってもよい。

#### 【0040】

処理システム 500 は、様々な有形プロセッサ可読記憶媒体及び無形プロセッサ可読通信信号を含んでもよい。有形プロセッサ可読記憶域は、処理システム 500 によってアクセスされ得、かつ揮発性及び不揮発性記憶媒体、取り外し可能及び取り外し不可記憶媒体の両方を含む、任意の利用可能媒体によって具現化され得る。有形プロセッサ可読記憶媒体としては、無形通信信号を除き、プロセッサ可読命令、データ構造、プログラムモジュール又は他のデータなどの情報を格納するための任意の方法又は技術で実施される、揮発性及び不揮発性、取り外し可能及び取り外し不可記憶媒体が挙げられる。有形プロセッサ可読記憶媒体としては、限定されるものではないが、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュメモリ若しくは他のメモリ技術、CD-ROM、デジタル多目的ディスク(DVD)若しくは他の光ディスク記憶域、磁気力セット、磁気テープ、磁気ディスク記憶域若しくは他の磁気記憶デバイス、又は所望の情報を格納するために使用され得、かつ処理システム 500 によってアクセスされ得る任意の他の有形媒体が挙げられる。有形プロセッサ可読記憶媒体に対して、無形プロセッサ可読通信信号は、プロセッサ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、又は搬送波若しくは他の信号伝達機構などの変調データ信号内に存在する他のデータを具現化し得る。用語「変調データ信号」は、信号内の情報を符号化するように設定又は変更されたその特性のうちの 1 つ以上を有する信号を意味する。一例として、限定されるものではないが、無形通信信号としては、有線ネットワーク又は直接有線接続などの有線媒体、並びに音響、RF、赤外線及び他の無線媒体などの無線媒体が挙げられる。

10

20

30

40

#### 【0041】

いくつかの実施例は、製品を含んでもよい。製品は、論理を格納するための有形記憶媒体を含んでもよい。記憶媒体の例としては、揮発性又は不揮発性メモリ、取り外し可能又は取り外し不可メモリ、消去可能又は消去不可メモリ、書き込み可能又は書き換え可能メモリなどを含む、電子データを格納することができる 1 つ以上のタイプのコンピュータ可読記憶媒体が挙げられ得る。論理の例としては、ソフトウェア構成要素、プログラム、アプリケーション、コンピュータプログラム、アプリケーションプログラム、システムプログラム、マシンプログラム、オペレーティングシステムソフトウェア、ミドルウェア、ファームウェア、ソフトウェアモジュール、ルーチン、サブルーチン、動作セグメント、メソッド、手順、ソフトウェアインターフェイス、アプリケーションプログラムインターフェイス(API)、命令セット、計算コード、コンピュータコード、コードセグメント、コンピュータコードセグメント、単語、値、記号、又はこれらの任意の組み合わせなど、様々なソフトウェア要素が挙げられ得る。一実施例では、例えば、製品は、コンピュータによって実行されたときに、コンピュータに記載された実施形態による方法及び/又は動作を実行させる、実行可能コンピュータプログラム命令を格納し得る。実行可能コンピュータプログラム命令としては、ソースコード、コンパイル済みコード、解釈済みコード、実行可能コード、静的コード、動的コードなどの任意の好適なタイプのコードが挙げられ得る。実行可能コンピュータプログラム命令は、特定の動作セグメントを実行するようにコンピュータに命令するための、既定のコンピュータ言語、方法又は構文に従って実施されてもよい。命令は、任意の好適な高レベル、低レベル、オブジェクト指向、視覚、コンパイル済み及び/又は解釈済みのプログラミング言語を使用して実施されてもよい。

50

#### 【0042】

データ記憶域及び/又はメモリは、ハードディスク媒体、複数の記憶デバイスを含む記憶域アレイ、光学媒体、ソリッドステートドライブ技術、ROM、RAM、及び他の技術などの、様々なタイプのプロセッサ可読記憶媒体によって具現化されてもよい。動作は、マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサコア、マイクロコントローラ、特定用途向け回路、又は他の処理技術によって実行又は補助されるか否かにかかわらず、ファームウェア、ソフトウェア、配線回路、ゲートアレイ技術及び他の技術に実施されたプロセッサ実行

50

可能命令であってもよい。書き込みコントローラ、記憶コントローラ、データ書き込み回路、データ読み出し及び復元回路、ソートモジュール、及びデータ記憶システムの他の機能モジュールが、システム実施プロセスを実施するプロセッサ可読命令を処理するためのプロセッサを含むか又はこれと共同して動作し得ることが理解されるべきである。

【0043】

本明細書に記載された本開示の技術の実施形態は、1つ以上のコンピュータシステム内の論理的工程として実施される。本開示の技術の論理的動作は、(1)1つ以上のコンピュータシステム内で実行する一連のプロセッサ実施工程として、及び(2)1つ以上のコンピュータシステム内の相互接続マシン又は回路モジュールとして実施される。実施例は、本開示の技術を実施するコンピュータシステムの性能要求に基づいて選択される。したがって、本明細書に記載されている、本開示の技術の実施形態を形成する論理的動作は、動作、工程、物体、又はモジュールとして、様々に言及される。更に、論理的動作が、明白に別途特許請求されるか又は特定順序が請求項の記載によって本質的に必要とされない限り、所望により追加及び省略しながら任意の順序で実施され得ることが理解されるべきである。

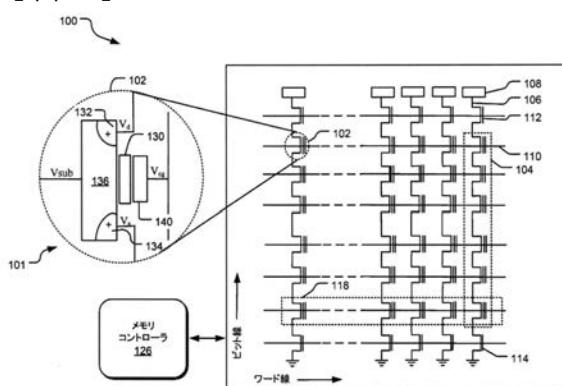
10

【0044】

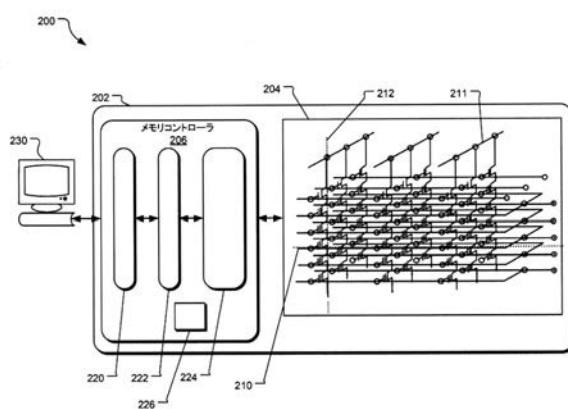
上記の詳述、例、及びデータは、本開示の技術の例示的実施形態の構造及び使用の完全な説明を提供する。本開示の技術の多くの実施形態が本開示の技術の概念及び範囲から逸脱することなく成され得るので、本開示の技術は、以下に添付の特許請求の範囲に帰する。更に、異なる実施形態の構造的特徴は、記載された請求項から逸脱することなく更に別の実施形態に組み合わせられ得る。

20

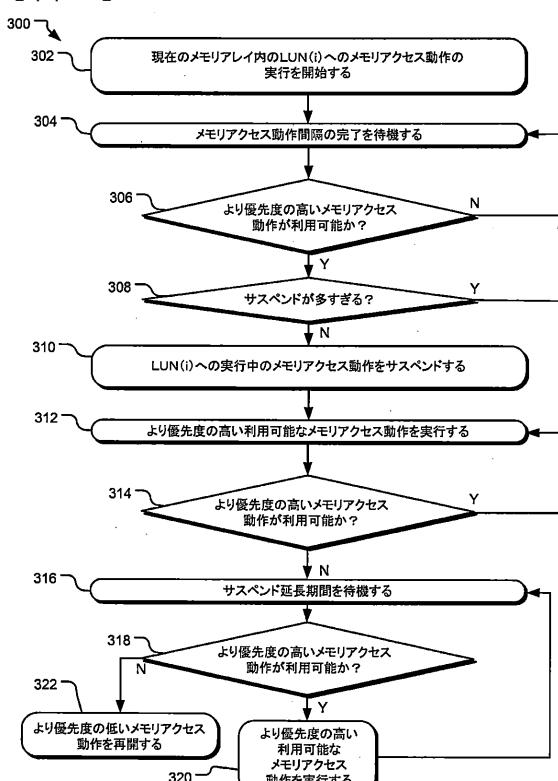
【図1】



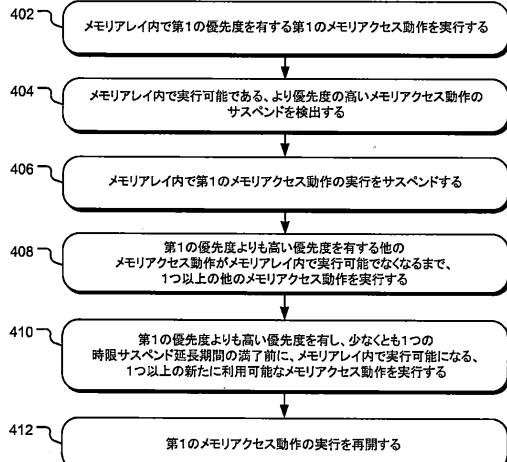
【図2】



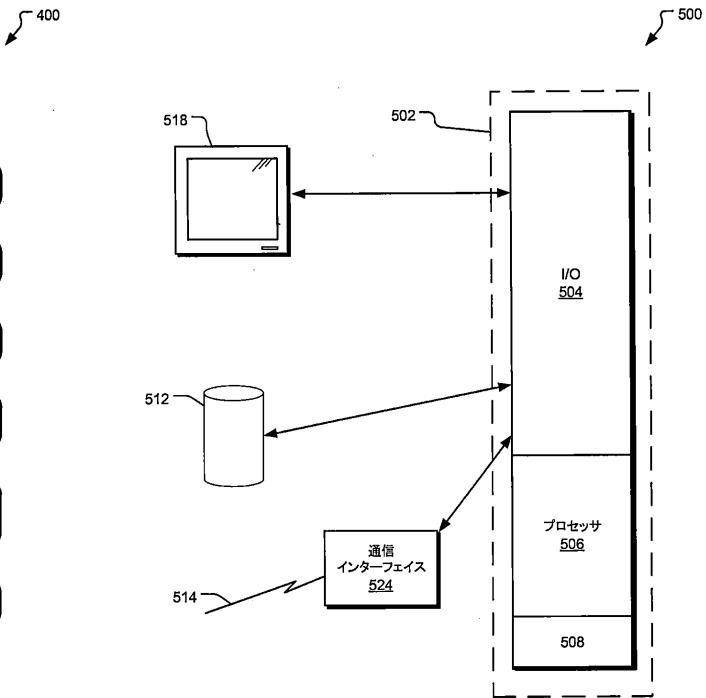
【図3】



【図4】



【図5】



---

フロントページの続き

- (72)発明者 デイビッド・スコット・エプセン  
アメリカ合衆国、55305 ミネソタ州、ミネトンカ、リッジマウント・アベニュー・ウエスト、  
11905
- (72)発明者 ダナ・リン・シモンソン  
アメリカ合衆国、55060 ミネソタ州、オワトナ、オークビュー・ドライブ、1071
- (72)発明者 アブデルハキム・アルフセイン  
アメリカ合衆国、95031 カリフォルニア州、サン・ノゼ、エメラルド・ヒルズ・サークル、  
2288
- (72)発明者 エリッヒ・フランツ・ハラチュ  
アメリカ合衆国、95135 カリフォルニア州、サン・ノゼ、クレセント・ビレッジ・サークル  
、310、アパートメント・1229
- (72)発明者 スティーブン・ハウ  
アメリカ合衆国、55902 ミネソタ州、ロチェスター、メイヨーウッド・コモン・サークル・  
サウス・ウエスト、2951
- F ターム(参考) 5B160 CA13 CD13  
5B225 BA01 CA01 DE12 DE20 EA05 FA01

【外國語明細書】

2019200833000001.pdf